








Optoelectrical element and method of making the same.

Patent number: EP0660467
Publication date: 1995-06-28
Inventor: SPAETH WERNER DIPL-PHYS (DE); ALTHAUS HANS LUDWIG DR RER NAT (DE); DIETRICH RALF ING GRAD (DE); GRAMANN WOLFGANG (DE)
Applicant: SIEMENS AG (DE)
Classification:
- **International:** H01S3/025
- **European:** H01S5/022
Application number: EP19930120734 19931222
Priority number(s): EP19930120734 19931222

Also published as:

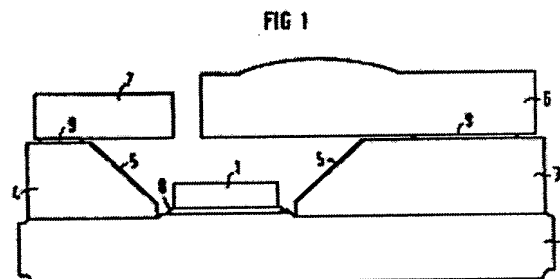
 JP7202350 (A)
 EP0660467 (B1)

Cited documents:

 EP0199565
 US4807238
 GB2213957
 JP58097885
 JP3011783
more >>

Abstract of EP0660467

In the case of an optoelectronic element having a laser chip (1) as light emitter and lens coupling optics (6) for defined emission of the radiation produced in the laser chip (1), the intention is for the lens coupling optics (6) arranged directly in front of the laser chip (1) to be adjusted and stably fixed in a simple fashion and for the element to be efficiently produced in the wafer structure. The laser chip (1) is arranged on a common carrier (2) between two carrier parts (3, 4), whose side faces which are next to the resonator faces of the laser chip (1) are provided with mirror layers (5) and are inclined with respect to the resonator faces at an angle of 45 DEG, so that the radiation produced in the laser chip (1) is directed almost vertically upwards relative to the surface of the common carrier (2), and the lens coupling optics (6) are arranged on at least one carrier part (3) in such a way that the radiation produced in the laser chip (1) is incident on the lens coupling optics almost perpendicularly.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

Best Available Copy



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 660 467 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **93120734.4**

51 Int. Cl.⁶: **H01S 3/025**

22 Anmeldetag: **22.12.93**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.06.95 Patentblatt 95/26

84 Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**

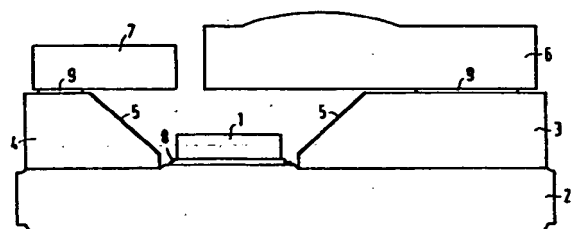
71 Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE)

72 Erfinder: **Althaus, Hans Ludwig, Dr. rer. nat.**
Georgstrasse 12
D-93138 Lappersdorf (DE)
Erfinder: **Dietrich, Ralf, Ing. grad.**
Agilolfingerplatz 5
D-81543 München (DE)
Erfinder: **Gramann, Wolfgang**
Riesengebirgstrasse 79
D-93057 Regensburg (DE)
Erfinder: **Späth, Werner, Dipl.-Phys.**
Burgstallstrasse 50
D-83607 Holzkirchen (DE)

54 **Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung.**

57 Bei einem optoelektronischen Bauelement mit einem Laserchip (1) als Lichtsender und einer Linsenkoppeloptik (6) zum definierten Abstrahlen der im Laserchip (1) erzeugten Strahlung soll die unmittelbar vor dem Laserchip (1) angeordnete Linsenkoppeloptik (6) auf einfache Weise justiert und stabil fixiert und das Bauelement im Waferverband rationell hergestellt werden. Der Laserchip (1) ist auf einem gemeinsamen Träger (2) zwischen zwei Trägerteilen (3, 4) angeordnet, deren den Resonatorflächen des Laserchips (1) benachbarte Seitenflächen mit Spiegelschichten (5) versehen und zu den Resonatorflächen in einem Winkel von 45° geneigt sind, so daß die im Laserchip (1) erzeugte Strahlung zur Oberfläche des gemeinsamen Trägers (2) nahezu senkrecht nach oben gerichtet ist, und auf mindestens dem einen Trägerteil (3) ist die Linsenkoppeloptik (6) so angeordnet, daß die im Laserchip (1) erzeugte Strahlung auf diese nahezu senkrecht auftrifft.

FIG 1



Best Available Copy

EP 0 660 467 A1

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement mit einem Laserchip als Lichtsender und einer Linsenkoppeloptik zum definierten Abstrahlen der im Laserchip erzeugten optischen Strahlung sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung.

Optoelektronische Bauelemente mit einer Linsenkoppeloptik sind bekannt und beispielsweise in der EP-A-0 412 184 beschrieben.

Derartige Opto-Halbleiterbauelemente dienen insbesondere als Lichtsendebauelemente zum Kopeln an Lichtwellenleiter. Die für die optische Kopplung zwischen einem Halbleiter-Laser und einem Lichtleiter, beispielsweise einer Glasfaser, insbesondere in der optischen Daten- und Nachrichtentechnik verwendeten, bekannten Bauelemente leiden in der Regel darunter, daß sie wegen der Abstrahlung der kohärenten Strahlung des Laserchips von dessen Kante, d.h. in dessen Montageebene, teure Einzelkomponenten und aufwendige Montageprozesse erfordern.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein optoelektronisches Bauelement der eingangs genannten Art derart auszubilden, daß eine unmittelbar vor dem Laserchip angeordnete Linsenkoppeloptik auf einfache Weise justiert und stabil fixiert werden kann und ein besonders rationelles Verfahren zu dessen Herstellung anzugeben, das sowohl eine vereinfachte Montage des Laserchips als auch der mechanischen Verbindungs- und optischen Abbildungselemente im Waferverband ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein Verfahren zu dessen Herstellung nach Anspruch 9 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand zusätzlicher Ansprüche.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß das optoelektronische Bauelement einen Aufbau besitzt, der unter Nutzung von Komponenten und Techniken der Mikromechanik und Mikrooptik sowohl eine vereinfachte Montage des Laserchips auf einem Subträger (Submount) als auch eine besonders rationelle Herstellung einer Vielzahl derartiger Bauelemente im Scheibenverband erlaubt. Dabei können gleichzeitig alle mechanischen Verbindungs- und optischen Abbildungselemente sowie die Laserchips montiert und dann vereinzelt werden. Das optoelektronische Bauelement zeichnet sich durch einen raumsparenden Aufbau, eine mechanisch stabile Linsenkoppeloptik und eine definierte Abstrahlcharakteristik aus.

Anhand eines in den Figuren der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels wird die Erfindung im folgenden näher erläutert.

Es zeigen

FIG 1 ein optoelektronisches Bauelement im

Schnitt und

FIG 2 ein optoelektronisches Bauelement beim Herstellen im Waferverband.

Das in FIG 1 als Einzelbauelement und in FIG 2 im Scheibenverband dargestellte optoelektronische Bauelement besteht im wesentlichen aus einem Laserchip 1 als Lichtsender und einer Linsenkoppeloptik 6 zum definierten Abstrahlen der im Laserchip erzeugten optischen Strahlung. Der Laserchip 1 ist auf einem gemeinsamen Träger 2 angeordnet, der vorzugsweise aus Silizium besteht und als Submount beispielsweise auf die Bodenplatte eines TO-Gehäuses montiert werden kann. Der Laserchip 1 ist auf dem gemeinsamen Träger 2 zwischen zwei Trägerteilen 3, 4 angeordnet, deren den optischen Resonatorflächen des Laserchips 1 benachbarte Seitenflächen mit Spiegelschichten 5 versehen und zu den Resonatorflächen in einem Winkel von 45° geneigt sind, so daß die im Laserchip 1 erzeugte kohärente Strahlung zur Oberfläche des gemeinsamen Trägers 2 nahezu senkrecht nach oben umgelenkt wird. Die beiden Trägerteile 3, 4 bestehen vorzugsweise aus Glas und weisen ein trapezförmiges Profil auf. Insbesondere zur Vereinfachung der Justage und Befestigung dieser beiden Trägerteile 3, 4 ist es vorteilhaft, in dem gemeinsamen Träger 2 hierzu passende Vertiefungen bzw. Gräben vorzusehen, in die die Trägerteile 3, 4 dann eingefügt und darin befestigt sind. Als Spiegelschichten 5 sind auf den benachbarten Seitenflächen der Trägerteile 3, 4 zweckmäßig Schichten aus dielektrischem Material aufgebracht. Auf mindestens dem einen Trägerteil, in diesem Ausführungsbeispiel auf dem Trägerteil 3, ist die Linsenkoppeloptik 6 so angeordnet und befestigt, daß die im Laserchip 1 erzeugte Strahlung auf diese nahezu senkrecht auftrifft.

Die Linsenkoppeloptik 6 ist vorzugsweise ein Linsenchip mit integrierter refraktiver und/oder diffraktiver Linse. Dieser Linsenchip bzw. die Linsenkoppeloptik 6 kann auch den Laserchip 1 überspannend auf beiden Trägerteilen 3, 4 justiert und fixiert sein. Der Linsenchip besteht je nach der vom Laserchip 1 emittierten Wellenlänge zweckmäßig aus einem entsprechend durchlässigen Glas oder Halbleitermaterial wie Silizium, Siliziumkarbid oder Galliumphosphid. Der Linsenchip, der als Linsenkoppeloptik 6 einseitig auf nur einem Trägerteil oder beidseitig auf beiden Trägerteilen 3, 4 angeordnet werden kann, wird vorteilhaft mit seiner strukturierten und/oder gekrümmten Seite nach unten, d.h. dieser dem Laserchip 1 zugewandten Seite auf das eine oder auf beide Trägerteile 3, 4 aufgebracht und befestigt. Eine solche Anordnung ist insbesondere toleranzfreundlicher als eine Anordnung mit äußerer Krümmung bzw. Struktur. Als Linsenkoppeloptik 6 kann außer einem Linsenchip mit integrierter Linse beispielsweise auch eine Ku-

Best Available Copy

gellinse oder Zylinderlinse verwendet werden, die in einer Öffnung in einem Linsenträger befestigt ist, der z.B. aus Silizium besteht.

Für bestimmte Anwendungen des optoelektronischen Bauelements wird zweckmäßig auf dem einen der beiden Trägerteile 3, 4 oder auf dem Linsenchip, sofern dieser auf beiden Trägerteilen 3, 4 aufgebracht ist, ein Monitor-Chip 7 derart angeordnet und befestigt, daß von diesem ein Teil der vom Laserchip 1 erzeugten optischen Strahlung empfangbar ist. Zu diesem Beispiel ist der Monitorchip 7 auf dem Trägerteil 4 befestigt und empfängt das vom Laserchip 1 emittierte und vom Spiegel 5 reflektierte Laser-Rückseitenlicht.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführung des erfindungsgemäßen optoelektronischen Halbleiterbauelementes, das in einem Waferverband gleichzeitig in einer Vielzahl hergestellt werden kann, ist gemäß FIG 1 und 2 eine vorzugsweise aus Silizium bestehende Scheibe als gemeinsamer Träger 2 bzw. Submount mit geeigneten metallischen Strukturen 8 zur Bondung der Laserchips 1 versehen. In diesem Träger 2 werden zweckmäßig parallele Vertiefungen bzw. Gräben beispielsweise von einigen 100µm Breite und Abstand geätzt. Die Grabentiefe kann von einem bis zu einigen 100µm betragen. In diese Vertiefungen oder auf den gemeinsamen Träger 2 direkt werden Trägerteile 3, 4 vorzugsweise in Gestalt von Prismenstreifen mit trapezförmigem Profil, bei dem sich die Verlängerungen der beiden Seitenflächen in einem rechten Winkel schneiden, eingebracht und anodisch oder durch Löttechnik gebondet. Die benachbarten Seitenflächen der Trägerteile 3, 4 sind mit Spiegelschichten 5 versehen. Mit Vorteil werden dielektrische Spiegel aus Schichtfolgen wie SiO₂-TiO₂, SiO₂-Si, Al₂O₃-Si oder Kombinationen dieser Schichtenfolgen oder anderer dielektrischer Schichten angebracht. Die schmalere Oberseite der prismenförmigen Trägerteile 3, 4 kann mit einer lötfähigen Metallschichtstruktur 9 z.B. aus Ti-Pt-Au, Cr-Pt-Au, Ti-Ni-Au, Ti-Pt-AuSn, Ni-Au oder anderen lötfähigen Schichten versehen werden.

Zum Aufbau der Lasereinheit bzw. des optoelektronischen Bauelements werden nun auf die auf dem gemeinsamen Trägerteil (Si-Submount) vorgesehenen Metallpads bzw. metallischen Strukturen 8 die Laserchips 1, die auf der dem Träger 2 zugewandten Unterseite je nach Anforderung mit einer Lotschicht aus AuSn, AuGe, AuSi, PbSn oder anderen lötfähigen Schichten von ca. 1µm bis 10µm Dicke versehen sind, in einem definierten Abstand vor den Trägerteilen 3, 4 festgelötet. Die erforderliche Energie für die Lötung kann durch verschiedene Verfahren, wie HF-Heizung, WIG-Heizung, Heatpipe-Heizung oder durch Laserstrahlung in die zu befestigende Unterseite des Laserchips 1 eingekoppelt werden. Von Vorteil ist es, den ge-

meinsamen Träger 2 (vorzugsweise Siliziumscheibe) so vorzuheizen, daß die für den Lötvorgang erforderliche Temperatur mit wenig Zusatzenergie erreicht wird. Um diese besonders niedrig zu halten, kann durch bestimmte Maßnahmen, z.B. Einschnitte zwischen den einzelnen Laserchips 1, die von deren Unterseite bis zu den Trägerteilen 3, 4 gehen können, der Abfluß der zugeführten Energie zu den Nachbarchips stark reduziert werden. Die Oberseite des Laserchips 1 wird mit einem dafür vorgesehenen Pad auf dem gemeinsamen Träger 2 verbunden.

Die besondere Ausführung des Lasersubmounts, d.h. des gemeinsamen Trägers 2, mit reflektierenden prismenförmigen Trägerteilen 3, 4 zur Strahlumlenkung ermöglicht es nun, das in der Halbleitertechnik übliche, bisher bei den bekannten Laser-Kantenstrahlern nicht anwendbare Testen auf einem Standardwaferprober mit nur einem zusätzlichen optischen Meßkopf zur Erfassung der optoelektronischen Größen einzusetzen.

Nach der Messung kann die Scheibe (Wafer) wahlweise in die einzelnen Submounts (Träger 2) aufgetrennt werden, wobei jeder Submount (Träger 2) einen Laserchip 1 und je einen Teil der prismenförmigen Trägerteile 3, 4 vor der Vorder- und Rückseite des Laserchips 1 enthält. Das Auftrennen der Scheibe bzw. das Vereinzeln der Bauelemente bzw. deren Submounts geschieht gemäß FIG. 2 längs der Trennsuren 10. Die Aufteilung der Scheibe, vorzugsweise Siliziumscheibe (Träger 2) in einzelne Submounts kann auch bereits vor Montage der Laserchips 1 vorgenommen werden. Die Submounts können dann einzeln weiterverarbeitet werden.

Vor oder nach der Vereinzelung der Submounts wird dann eine Linsenkoppeloptik 6 hier in Gestalt eines Linsenchips, dessen Linse refraktiv und/oder diffraktiv sein kann, aktiv oder passiv, d.h. mit oder ohne Laserbetrieb als Hilfsmittel, über der Spiegelschicht 5 des Trägerteils 3 vor der Vorderseite des Laserchips 1 in x- und y-Richtung justiert und zweckmäßig durch eine Lötung oder Klebung auf der Oberfläche des Trägerteils 3 befestigt. Die erforderliche Energie für die Lötung kann z.B. durch eine Stromdirektheizung des Linsenchips oder durch Strahlungsheizung durch einen Laser (Halbleiter-Leistungslaser, Festkörperlaser, CO₂-Laser usw.) in den Linsenchip eingebracht werden. Das notwendige Lot kann z.B. durch Aufdampfen auf den Linsenchip aufgebracht worden sein, das dann zur Fixierung unter Druckkontakt zur Unterlage (Trägerteil 3) aufgeschmolzen wird. Der Widerstand des Trägerteils 3, beispielsweise Glasprismas, ist so bemessen, daß nur eine unwesentliche Erwärmung des Materials des Trägers 2, beispielsweise Si-Substrats, beim Lötvorgang erfolgt.

Die Summe der Abstände Vorderseite des Laserchips 1 - Trägerteil 3, Trägerteil 3 - Linsenchip 6 plus optische Dicke der Linse im Linsenchip 6 ergibt die Gegenstandsweite der optischen Abbildung. Diese kann bei festem Abstand Trägerteil 3 - Linsenchip 6 und fester optischer Dicke der Linse im Linsenchip 6 allein über eine Lateralverschiebung, also Änderung des Abstandes der Vorderseite des Laserchips 1 zum Trägerteil 3 hin oder von diesem weg eingestellt bzw. variiert werden. Die z-Justage ist so auf eine einfache Lateraljustage transformiert worden. Damit läßt sich die Abbildung des Laserflecks sehr einfach auf den Kern einer Lichtleitfaser, die sich in einem vorgegebenen Abstand vor der Linse des Linsenchips 6 befindet, einstellen.

Die verwendeten Linsenchips können in einem Scheibenprozeß durch spezielle photolithographische und ätztechnische Prozesse hergestellt werden. Das Linsenmaterial wird je nach den technischen Anforderungen ausgewählt. Für Wellenlängen größer $1,1\mu\text{m}$ wird mit Vorteil Silizium verwendet, für kürzere Wellenlängen spezielle Gläser oder Halbleitermaterial wie z.B. Galliumphosphid oder Siliziumkarbid. Silizium kann aber auch nur Träger für Linsen sein. Die Verwendung von Silizium ergibt bezüglich Temperaturänderungen einen besonders stabilen Aufbau, da gemeinsamer Träger 2 (Submount), Trägerteile 3, 4 (z.B. Glasprismen) und Linsenkoppeloptik 6 (Linsenchips) in den in Frage kommenden Temperaturintervallen nahezu gleichen Ausdehnungskoeffizienten haben.

Falls erforderlich, kann auf der Oberseite des einen Trägerteils 4, das dem Trägerteil 3 gegenüberliegt, das die Linsenkoppeloptik 6 trägt, eine geeignete Monitordiode 7 in der Weise aufgebracht werden, daß ein Teil der Diode über die auf dem Trägerteil 4 aufgebrachte Spiegelschicht 5 hinausragt. Somit können die aus dem hinteren Spiegel (hintere Resonatorseite) des Laserchips 1 austretenden und an der benachbarten Spiegelschicht 5 nach oben reflektierten Photonen (Rückseitenlicht) über das transparente Substrat des Monitorchips 7 den pn-Übergang der Monitordiode erreichen. Bei Monitordioden mit nichttransparentem Substrat wird die Diode mit dem pn-Übergang nach unten auf das Trägerteil 4 aufgebracht. Der Monitorchip 7 kann aber auch über der Linsenkoppeloptik 6 angeordnet werden oder in ihn integriert sein, sofern sich beispielsweise ein Linsenchip über beide Trägerteile 3, 4 erstreckt.

Nach optoelektronischer Prüfung können die gemeinsamen Träger 2 (Submounts), auf denen sich Laserchip 1, Trägerteile 3 und 4, Linsenkoppeloptik 6 und Monitorchip 7 befinden, also die Mikromodule, wie ein üblicher Halbleiterchip in Die- und Wirebondtechnik auf einen vorgesehenen Gesamtträger, beispielsweise die Bodenplatte eines TO-

Gehäuses montiert werden.

Es ist von Vorteil, die Lichteintrittsfläche der Monitordiode 7 und die Linsenkoppeloptik 6, insbesondere die Linse, mit einer optischen Vergütung zur Verminderung der Reflexionsverluste zu versehen.

Patentansprüche

1. Optoelektronisches Bauelement mit einem Laserchip als Lichtsender und einer Linsenkoppeloptik zum definierten Abstrahlen der im Laserchip erzeugten Strahlung, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Laserchip (1) auf einem gemeinsamen Träger (2) zwischen zwei Trägerteilen (3, 4) angeordnet ist, deren den Resonatorflächen des Laserchips (1) benachbarte Seitenflächen mit Spiegelschichten (5) versehen und zu den Resonatorflächen in einem Winkel von 45° geneigt sind, so daß die im Laserchip (1) erzeugte Strahlung zur Oberfläche des gemeinsamen Trägers (2) nahezu senkrecht nach oben gerichtet ist, und daß auf mindestens dem einen Trägerteil (3) die Linsenkoppeloptik (6) so angeordnet und befestigt ist, daß die im Laserchip (1) erzeugte Strahlung auf diese nahezu senkrecht auftrifft.
2. Bauelement nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der gemeinsame Träger (2) aus Silizium besteht.
3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Trägerteile (3, 4) aus Glas oder aus Silizium bestehen und ein trapezförmiges Profil aufweisen.
4. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Trägerteile (3, 4) in Vertiefungen im gemeinsamen Träger (2) eingefügt sind.
5. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Spiegelschichten (5) auf den benachbarten Seitenflächen der Trägerteile (3, 4) Schichten aus dielektrischem Material sind.
6. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Linsenkoppeloptik (6) ein Linsenchip mit integrierter refraktiver und/oder diffraktiver Linse ist.
7. Bauelement nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Linsenchip aus Silizium, Siliziumkarbid, Galliumphosphid oder aus Glas besteht.

Best Available Copy

8. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß auf dem einen der beiden Trägteile (3, 4) oder auf der Linsenkoppeloptik (6) ein Monitor-Chip (7) derart angeordnet und befestigt ist, daß von diesem ein Teil der vom Laserchip (1) erzeugten optischen Strahlung empfangbar ist. 5
9. Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl optoelektronischer Bauelemente nach einem der Ansprüche 1 bis 8 im Scheibenverband, **dadurch gekennzeichnet**, daß in eine Silizium-Scheibe als gemeinsamen Träger (2), die mit geeigneten metallischen Strukturen zur Bondung der Laserchips (1) versehen wird, voneinander beabstandete, parallele Vertiefungen eingätzt werden, daß in diese Vertiefungen als Trägteile (3, 4) Prismenstreifen mit trapezförmigem Profil eingebracht und anodisch oder durch Löttechnik gebondet werden, deren benachbarte Seitenflächen mit Spiegelschichten (5) versehen sind, daß die Laserchips (1) in einem definierten Abstand vor den Trägteilen (3, 4) angeordnet und befestigt werden, und daß dann die Silizium-Scheibe in die einzelnen Bauelemente im Bereich der Trägteile (3, 4) aufgetrennt wird. 10
15
20
25
10. Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Vereinzeln der Silizium-Scheibe vor dem Aufbringen der Laserchips (1) vorgenommen wird. 30
11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Linsenkoppeloptik (6) ein Linsenchip über der Spiegelschicht (5) des einen Trägteils (3) vor der Vorderseite des Laserchips (1) in x- und y-Richtung justiert und durch Lötung oder Klebung auf der Oberfläche des Trägteils (3) befestigt wird. 35
40
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß über der Spiegelschicht (5) des zweiten Trägteils (4) vor der Rückseite des Laserchips (1) ein Monitor-Chip (7) justiert und fixiert wird. 45

Best Available Copy

Best Available Copy

FIG 1

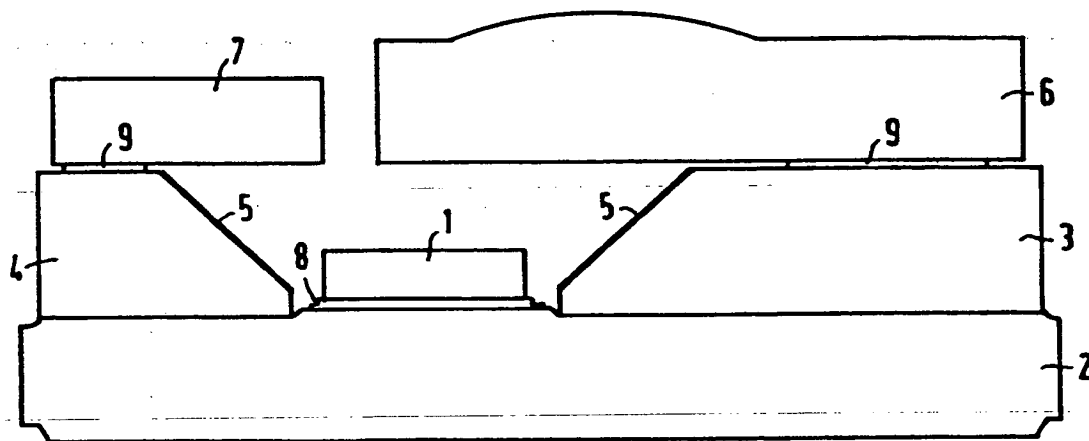
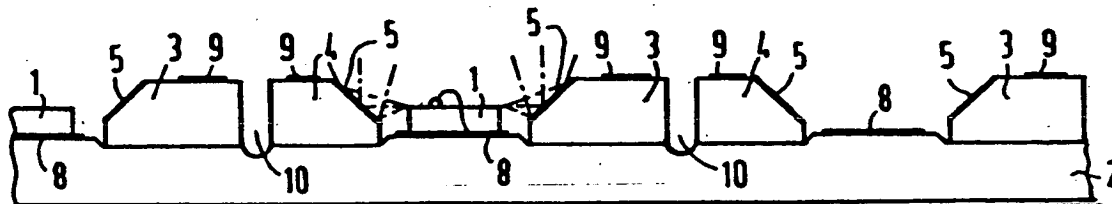


FIG 2





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 93 12 0734

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|--|--|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CL6) |
| Y A | EP-A-0 199 565 (SONY CORP) * das ganze Dokument * | 1 2,3,8,9 | H01S3/025 |
| Y A | US-A-4 807 238 (YOKOMORI) * Spalte 6; Abbildungen 12-16,21 * | 1 2-7,9-11 | |
| A | GB-A-2 213 957 (STC PLC) * Seite 1 - Seite 2; Abbildung 5 * | 1,8,9, 11,12 | |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 200 (E-196) 3. September 1983 & JP-A-58 097 885 (NIPPON DENKI KK) * Zusammenfassung * | 1-4,9,10 | |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 125 (E-1050) 27. März 1991 & JP-A-03 011 783 (NTT) * Zusammenfassung * | 1 | |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 88 (E-721) 28. Februar 1989 & JP-A-63 265 483 (MATSUSHITA ELECTRIC CO) * Zusammenfassung * | 1,9,10 | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CL6) H01S |
| Best Available Copy | | | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort DEN HAAG | | Abschlußdatum der Recherche 6. Mai 1994 | |
| | | Prüfer Claessen, L | |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |